

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
руководителя отделения
в отделении Физики диэлектриков и полупроводников
Вакансия VAC_26775

Тематика исследований

Исследования и разработки в области физики и технологии диэлектриков и полупроводников, включая общее руководство следующими направлениями: фазовые состояния и их эволюция в сегнетоэлектрических и магнитных кристаллах и структурах; сверхбыстрые фотоиндуцированные магнитные явления; рассеяние нейтронов в твердых телах, критическая динамика и эволюция микроструктуры в разупорядоченных системах и наноструктурах; динамика структурных превращений в биополимерах; низкотемпературные кинетические и магнитные явления в металлических, полупроводниковых наноструктурированных материалах и сверхпроводниках в сильных магнитных полях и при высоких давлениях; исследования и разработки в области физики и технологии термоэлектриков и термоэлектрического преобразования энергии; технология широкозонных полупроводников с большой энергией связи — SiC, GaN, AlN и создание приборов на их основе; редкоземельные полупроводники, датчики физических величин и преобразователи тепловой энергии в электрическую на их основе; создание и изучение наноструктур в пористых матрицах; системы и методы неразрушающего исследования и контроля на основе адаптивных интерферометров; разработка новых методов в области рентгеновской дифракции и изучение структурного состояния кристаллов, поверхностных слоев и наносистем; катодоллюминесценция в материалах и структурах с наноразмерными элементами при высокоэнергетическом возбуждении; теория коллективных эффектов и кооперативных явлений в полупроводниках, диэлектриках, наноструктурах и в коррелированных системах с пониженной размерностью; статистическая физика случайных сетей.

Трудовая деятельность

Осуществление научного руководства конкретными темами исследований согласно государственному заданию и планам НИР по утвержденным целевым программам, а также подготовка и подача заявок на новые проекты в рамках базового бюджетного и целевого финансирования; руководство работой коллективов сотрудников, выполняющих эти исследования и обеспечение выполнения ими правил внутреннего распорядка в учреждении. Непосредственное участие в выполнении исследований: разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координация деятельности коллективов исполнителей и соисполнителей работ; обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения. Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации, а также в подготовке аспирантов и специалистов с высшим образованием в соответствующей области.

Особенности трудовой деятельности: руководитель отделения Физики диэлектриков и полупроводников работает со сведениями, составляющими государственную тайну по ф. 3.

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в отделении Физики диэлектриков и полупроводников на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время,

при оценке претендентов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к их квалификации.

- Наличие у претендента ученой степени доктора физико-математических наук.
- Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том числе: опубликованных произведений (шт.) не менее 120,
- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования: Web of Science (шт.) не менее 60, РИНЦ (шт.) не менее 60.
- Индекс Хирша не ниже 11.
- Опыт научной работы не менее 25 лет.

За последние 5 лет: руководство не менее чем 1 проектом в рамках ПФНИ Президиума РАН, не менее чем 1 проектом РФФИ, не менее чем 1 международным проектом; объем средств, полученных организацией при участии претендента из внебюджетных источников, договоров – не менее 18,5 млн. руб.; подготовка научных кадров высшей квалификации (кандидаты наук, аспиранты, магистры, соискатели) не менее 1.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).